




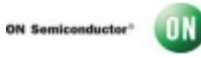




	<h2>STD80N10F7</h2>
	<p>제조업체 부품 번호: STD80N10F7</p> <p>제조업체 / 브랜드: N/A</p> <p>설명일부: MOSFET N-CH 100V 70A DPAK</p> <p>RoHs 상태: 무연 / RoHS 준수</p> <p>재고 상태: New original, 63165 pcs Stock Available.</p> <p>에서 운송된다: Hong Kong</p> <p>선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

명세서

제품 모델	STD80N10F7
제조사	N/A
기술	MOSFET N-CH 100V 70A DPAK
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글
부품 상태	63165 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	4.5V @ 250μA
Vgs (최대)	±20V
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	DPAK
연속	DeepGATE™, STripFET™ VII
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	10 mOhm @ 40A, 10V
전력 소비 (최대)	85W (Tc)
포장	Tape & Reel (TR)
패키지 / 케이스	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
작동 온도	-55°C ~ 175°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	3100pF @ 50V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	45nC @ 10V
FET 유형	N-Channel
FET 특징	-
드라이브 전압 (최대 Rds On, 최소 Rds On)	10V
소스 전압에 드레인 (Vdss)	100V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	70A (Tc)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 <p>STD7NS20T4 MOS ST ST TO-252</p>	 <p>STD80N6F7 QQ2850920 STD80N6F7 QQ2850920</p>	 <p>STD80N6F6 N/A MOSFET N-CH 60V DPAK</p>	 <p>STD7NS20T4 N/A MOSFET N-CH 200V 7A DPAK</p>
 <p>STD80N4F6 N/A MOSFET N-CH 40V 80A DPAK</p>	 <p>STD80N02-011 ON ON TO251</p>	 <p>STD80N3LL ST ST TO252</p>	 <p>STD80N02 ON STD80N02 ON</p>

STD80N10F7 관련 키워드

더

STD80N10F7	STD80N10F7 데이터 시트	STD80N10F7 데이터 시트	STD80N10F7 PDF	STD80N10F7
STD80N10F7 전자	STD80N10F7 부품	STD80N10F7 유통 업체	STD80N10F7 이미지	STD80N10F7 부품
STD80N10F7 가격	STD80N10F7 제조업체	STD80N10F7 사진	STD80N10F7 재고	STD80N10F7 인벤토리
STD80N10F7 새로운	STD80N10F7 원본	STD80N10F7 보증	STD80N10F7 RFQ	STD80N10F7 온라인 주문

Contact us: Info@YIC-Electronics.com

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2024 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited